

Облікова картка ДіР



I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0224U001461

Державний реєстраційний номер: 0122U200830

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 23-01-2024

II. Етап виконання ДіР

Номер етапу: 1

Назва етапу: Розроблення методик контролю параметрів шарів епітаксійної структури p-InSb/ n-InSb.

Початок етапу: 09.2022

Закінчення етапу: 12.2022

Вид звітнього документа: Проміжний звіт

III. Відомості про виконавця ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Науково-виробниче підприємство "Електрон-Карат"-дочірнє підприємство ПрАТ "Концерн-Електрон"

Код за ЄДРПОУ: 23273999

Місцезнаходження: вул. Стрийська, буд. 202, м. Львів, Львівська обл., 79031, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство економіки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 380322631065

IV. Відомості про співвиконавців ДіР

V. Відомості про замовника ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Міністерство освіти і науки України

Код за ЄДРПОУ: 38621185

Місцезнаходження: проспект Перемоги, буд. 10, м. Київ, 01135, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Кабінет Міністрів України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 380444813221

VI. Джерела, напрями та обсяги фінансування ДіР

Підстава для проведення ДіР: 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади, академією наук (головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)

Напрямок фінансування: 2.4 - розробки найважливіших новітніх технологій за державним замовленням

Джерела фінансування

7713 - кошти держбюджету

Код програмної класифікації видатків і кредитування (КПКВК): 2201040

Фактичний обсяг фінансування (тис. грн.): 700.000
--

VII. Відомості про ДіР

Назва роботи українською:

Розроблення технології росту структур на основі антимоніду індію та виготовлення тестових зразків фотодіодів

Назва роботи англійською:

Development of technology for growth of structures based on indium antimonide and production of test samples of photodiodes

Реферат українською:

Розроблена ескізна документація та виготовлена технологічна оснастка (графітова касета, кварцовий випаровувач для стибію) для імпульсного охолодження насиченого розчину-розплаву. Розроблена методика контролю товщини шарів епітаксійної структури p-InSb/n-InSb. Розроблена методика контролю типу провідності та концентрації носіїв заряду в епітаксійному шарі p-InSb.

Реферат англійською:

Draft documentation was developed and technological equipment was manufactured (graphite cassette, quartz evaporator for stibium) for pulsed cooling of the saturated solution-melt. A method of controlling the thickness of the layers of the epitaxial structure has been developed p-InSb/n-InSb. A method of controlling the type of conductivity and concentration of charge carriers in the p-InSb epitaxial layer has been developed.

Індекс УДК: 621.38.049.77.002; 621.375.82.002, 621.315

Коди тематичних рубрик: 47.13.11

Керівники роботи

Власне Прізвище Ім'я По-батькові: Круковський Семен Іванович

Науковий ступінь: д.т.н.

Вчене звання: с.н.с.

Ідентифікатор ORCID ID:

Додаткова інформація:

VIII. Наукова (науково-технічна) продукція (НТП)

Назва НТП українською: Методики контролю параметрів шарів епітаксійної структури p-InSb/n-InSb. Ескізна документація на технологічну оснастку. оснастку

Назва НТП англійською: Metodyky kontrolyu parametriv shariv epitaksiynoyi struktury r-InSb/n-InSb. Eskizna dokumentatsiya na tekhnolohichnu osnastku. п 122 / 5 000 Результати перекладу Результат перекладу Methods of controlling the parameters of the layers of the p-InSb/n-InSb epitaxial structure. Sketch documentation for technological equipment.

НТП, яку передбачалося створити:

Причини, через які НТП не було створено:

Отримані результати: Технології, Методи, теорії

Галузь застосування: Оптоелектроніка

Реєстраційний номер картки технології:

Опис НТП: Методика контролю товщини шарів епітаксійної структури p-InSb/n-InSb. Методика контролю типу провідності та концентрації носіїв заряду в епітаксійному шарі p-InSb. Ескізна документація на виготовлення технологічної оснастки (графітова касета, кварцовий випаровувач для стибію) для імпульсного охолодження насиченого розчину-розплаву. Акт про виготовлення технологічної оснастки (графітова касета, яка конструктивно забезпечує охолодження зворотного боку підкладки InSb, кварцовий випаровувач для стибію). Науково-технічний звіт за етап.

Соціально-економічна спрямованість НТП: Створення принципово нової продукції (матеріалів, технологій тощо) для забезпечення експортного потенціалу та заміщенню імпорту

Вплив НТП на довкілля:

Впровадження НТП: Не впроваджено

Практична реалізація НТП

Початок етапу: 09.2022

Закінчення етапу: 12.2022

Споживачі продукції:

Перспективні ринки:

Характер співробітництва з інвестором

Потрібний обсяг інвестицій, тис. грн.:

Права, що надаються інвестору після завершення роботи:

Наявність бізнес-плану:

Техніко-економічне обґрунтування:

Потенціальний обсяг продажу, тис. грн.:

Очікуваний термін окупності (років):

Додаткова інформація:

ІХ. Бібліографічний опис

Х. Заключні відомості

Керівник юридичної особи

Ваків Микола Михайлович

Д. Т. Н.

Перелік осіб-виконавців

Іжнін Ігор Іванович

(д. ф.-м. н., 01.04.10)

Кость Ярослав Ярославович

(к. т. н.)

Круковський Семен Іванович

(д. т. н., 05.27.06)

Притуляк Богдан Богданович

Рейкін Борис Олександрович

**Відповідальний за підготовку
облікових документів**

Круковський С.І.

Телефон

+38 (096) 839-83-70

Реєстратор

**Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є
відповідальним за реєстрацію наукової
діяльності**

